固物 2020 期末

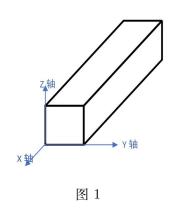
Deschain

2022年6月15日

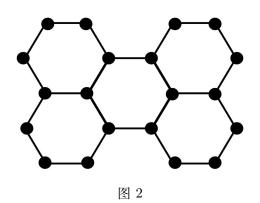
1. 填空题 (每空 1 分, 共 45 分)
(1) 具有长程有序的固体结构,即原子按照一定的周期规律排列的固体物质,称为,为了描述这种周
期性结构,将这种空间排列称为,周期性重复单元称为,其中体积最小的称为。
(2) Si 的晶体结构为 结构, Si 原子之间以 键结合, 属于 (简单/复式) 晶格, 其对应的布拉
非格子为 格子,倒格子为 格子。布里渊区为在倒格子空间中,以某倒格点为中心,由
中心格点到相邻格点的连线的垂直平分线所围成的多面体。
(3) 单晶硅在常温下导电,离子晶体在低温下导电。(能/不能)
(4) 有效质量与电子质量可以有很大差别,这是由于有效质量包含了
的电子的有效质量为, 此时在外场作用下, 电子从外场获得的动量(大于/小于) 它交给晶体的动
里。
(5) 一般情况下,本征半导体的费米能级 E_{F_i} 可以近似认为位于。N 型掺杂半导体的费米能级
E_{F_n} 向靠近; P 型掺杂半导体的费米能级 E_{F_P} 向靠近 (导带/价带)。若 P 型掺杂浓度为 N_a ,
温度为 T ,则有关系式 $E_{F_i} - E_{F_P} = k_B T ln(\frac{N_a}{n_i})$ 。
(6) 一般半导体材料中电子的迁移率_(>/ =) 空穴迁移率,这主要是由于的有效质量更大。</td
(7) 经典电子论中, 电子的功函数为电子真空能级与的能量差, 由材料本身的性质决定; 而量子理
论中电子的功函数为电子真空能级与的能量差。
(8) 有一掺杂半导体,当温度从 $0K$ 开始逐渐升高至其熔点时,半导体中的载流子浓度会经历先,然
后,最后再的过程。
(9) PN 结的形成。在 P 型半导体和 N 型半导体结合后,在其交界处产生了电子和空穴的浓度差,故电子会
从 N 区向 P 区发生 运动。该运动的结果使得交界面出 P 区—侧失去留下带电的杂质离子,N
区同理。这些不能移动的带电粒子在交界面附近形成了,其中的电场方向为,
电场强度在, 其宽度与掺杂浓度成。另一方面, 该电场使 P 区和 N 区的(多数/少数) 载
流子向另一侧发生运动。最后,这两种运动达到动态平衡。
(10) 一般的 PN 结在正常导通工作时,正极应接在 $_{-}$ (P/N) 区。光电二极管也是由一个 PN 结组成的
器件,当有特定频率的光入射到结区时,结区会产生大量电子——空穴对,若想将光生载流子引出形成
光电流,还需要外加偏压,此时正极应接在_(P/N)区。
(11) 如果要使金属和 N 型半导体形成肖特基接触,需要金属功函数_(>/ =) 半导体功函数,肖</td
特基势垒高度等于金属功函数和半导体之差。
(12) 简单晶格中的格波不存在(声学波/光学波);复式晶格的固体中格波存在光学波和声学波。
从物理意义的角度看,长波极限时,复式晶格声学波的特征为原胞做整体运动,频率较(高/低);而光
学波的特征为,频率较。
(13) 某一维原子链中有 N 个原子,相邻原子间距为 a 。考虑周期性边界条件,若为单原子链,则简约布

里渊区 $\left(-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right)$ 中格波波数的取值总数为_。若为交替排列的双原子链,简约布里渊区中格波波数的取值总数为。。

(14) 霍尔效应的实际应用。如图 1 所示,某沿 y,z 方向厚度皆为 1cm 的长方体未知掺杂半导体材料,沿 +x 方向通 50mA 的稳恒电流,沿 z 方向加磁感应强度为 0.5T 的静磁场,得到 y=0cm 和 y=0.1cm 面间的电势差为 +0.4mV。则该材料为 型掺杂,载流子浓度为 。(洛伦兹力遵循左手定则)

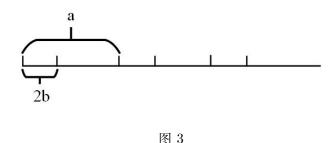


2. $(12 \, f)$ 石墨烯是一种 C 原子按正六边形排列的二维晶体,如图 2 所示,图中黑点代表 C 原子。相邻两个 C 原子间距为 0.142nm(本题中长度相关单位量纲请用 nm,数值计算误差在 5% 以上视为错误。)



- (1) 求石墨烯的晶格常数,原胞面积,以及倒格基矢的模长与夹角。
- (2) 画出第一、二、三布里渊区,并计算这三个布里渊区各自的面积。
- (3) 如果每个 C 原子有 4 个价电子, 求自由电子费米圆半径, 它会与第三布里渊区以外的布里渊区相交。如果考虑周期势场的微扰,请简单描述费米圆的形状应该如何修正(答对任意一点即可, 无需画图)?

3. $(15 \, \beta)$ 在绝对零度条件下,设一维晶体由 N 个双原子分子组成,如图 3 所示。晶体长度 L=Na, a 为相邻分子间距,每个分子中两个原子的间距为 2b。



(1) 若电子的势能函数可以表示为 δ 函数之和

$$W(x) = -V_0 \sum_{n=0}^{N-1} [\delta(x - na + b) + \delta(x - na - b)]$$

 V_0 为大于零的常数,请分别通过计算傅里叶系数得到第一、二布里渊区上的带隙宽度。

- (2) 在第(1)问的基础上,如果每个原子只有一个价电子,当 a > 4b 时,晶体是否为导体?特殊地,当 a = 4b 时,晶体是否为导体?请叙述理由。
- (3) 设 a > 4b, 在第(1)问的基础上,如果每个原子有两个价电子,想要通过调控每个分子中两个原子的间距来使该一维晶体导电,请问 a 和 b 应该满足怎样的关系?
- 4. (13 分) 室温 300K 时本征半导体 X 和 p 型掺杂半导体材料 Y 形成异质结,已知 X 和 Y 的禁带宽度分别为 $E_{gX}=0.66eV$ 和 $E_{gY}=1.42eV$,电子亲和能分别为 $\chi_X=4.13eV$ 和 $\chi_Y=4.07eV$,本征载流子浓度分别为 $\chi_X=2.4\times10^{13}cm^{-3}$ 和 $\chi_Y=1.79\times10^{6}cm^{-3}$, $\chi_X=2.4\times10^{13}cm^{-3}$ 和 $\chi_Y=1.79\times10^{6}cm^{-3}$, $\chi_X=1.016cm^{-3}$ 的掺杂浓度为 $\chi_X=1.016cm^{-3}$ 。
- (1) 求导带能级差 ΔE_C 和价带能级差 ΔE_V 。
- (2) 求 X 和 Y 费米能级 E_{FX} 和 E_{FY} 的位置,以及它们之间的接触电势差 V_D 。
- (3) 画出平衡时该异质结的能带图,并在图中标注真空能级、费米能级、导带底和价带顶的位置,以及禁带宽度、电子亲和能、 ΔE_C 、 ΔE_V 、 V_D 。(画出大致趋势即可,作图不要求数值比例严格)
- 5. $(15\ \mathcal{H})$ 有一长度为 L 的一价正负离子交错构成的一维晶格,平衡时正负离子间距为 a,正负离子质量分别为 2m 和 m,只计近邻两离子的相互作用势:

$$U(r) = -\frac{q^2}{r} + \frac{b}{r^{2n}}$$

其中, q 为电子电荷, b 和 n 为参量常数, 求:

- (1) 参数 b (用 q、n 和 a 表示);
- (2) 已知简谐近似时,在平衡位置附近有 $U(r) = U(a) + \frac{1}{2}\beta(r-a)^2$,求恢复力系数 β 。
- (3) 写出相邻的第 2n 和第 2n+1 两个离子的运动方程。考虑周期性边界条件,并分别代人简谐振动试解,根据方程解存在的条件,求出可能发生的格波频率解 ω 。
- (4) 画出简约布里渊区中格波色散关系曲线示意图,标出驻波点。
- (5) 求长波极限时, 光学波的频率 ω_0 和声学波的频率 ω_A 。

答案:

1. 填空题

- (1) ①晶体②晶格③晶胞④原胞
- (2) ①金刚石②共价③复式④体心立方
- (3) ①能②不能
- (4) ①晶格的周期性势场②负③小于
- (5) ①带隙中央②导带③价带
- (6) ①>②空穴
- (7) ①势阱底②费米能级
- (8) ①增大②基本不变③增大
- (9) ①扩散②空穴③负④空间电荷区⑤从 N 区指向 P 区⑥界面⑦反比 ⑧少数⑨漂移
- (10) ①P②N
- (11) ①>②电子亲和能
- (12) ①光学波②低③原胞内原子相对运动④高
- (13) @N@N
- (14) $@P@3.90625 \times 10^{22} m^{-3}$

2.

(1)

$$\begin{split} a &= 0.142\sqrt{3} = 0.2460nm \\ S &= 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 0.142^2 = 5.239 \times 10^{-2}nm^2 \\ \boldsymbol{b_1} &= \frac{2\pi}{\sqrt{3}a}(1,\sqrt{3}), \boldsymbol{b_2} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}a}(1,-\sqrt{3}) \\ \|\boldsymbol{b_1}\| &= \frac{4\pi}{\sqrt{3}a} = 29.50nm^{-1}, <\boldsymbol{b_1}, \boldsymbol{b_2} > = \frac{2\pi}{3} \end{split}$$

(2)

紫色、蓝色、绿色部分依次为第一、二、三布里渊区。

$$S_1 = S_2 = S_3 = (\frac{4\pi}{3a})^2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 6 = 753.6nm^{-2}$$

(3)
$$k_F = \sqrt{2\pi n} = 30.98nm^{-2}$$

b

3. (1)

$$W(x) = \sum V_n e^{j\frac{2\pi n}{a}x}, V_n = \frac{1}{a} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} W(x) e^{-j\frac{2\pi n}{a}x} dx = \frac{2V_0}{a} \cos(\frac{2\pi nb}{a})$$
$$V_{g_1} = |2V_1| = \frac{4V_0}{a} \cos(\frac{2b}{a}\pi), V_{g_2} = |2V_2| = \frac{4V_0}{a} \cos(\frac{4b}{a}\pi)$$

(2) a > 4b 不是导体, a = 4b 是导体。

 $(3) \ a = 8b$

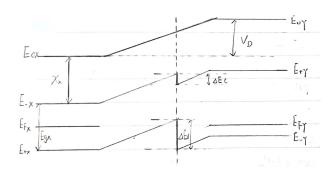
4.

$$\Delta E_C = \chi_X - \chi_Y = 0.06eV, \Delta E_V = |(\chi_X + E_{gX}) - (\chi_Y + E_{gY})| = 0.7eV$$

$$E_{FX} = -(\chi_X + \frac{1}{2}E_{gX}) = -4.46eV, E_{FiY} = -(\chi_Y + \frac{1}{2}E_{gY}) = -4.78eV$$

$$E_{FY} = E_{FiY} - k_B T ln(\frac{N_a}{n_i}) = -5.36eV, V_D = \frac{E_{FX} - E_{FY}}{e} = 0.9V$$

(3)



5.

$$\left. \frac{dU}{dr} \right|_{a} = \frac{q^2}{r^2} - \frac{2nb}{r^{2n+1}} = 0, b = \frac{q^2}{2n}a^{2n-1}$$

(2)

$$U(r) = U(a) + \frac{dU}{dr} \Big|_{a} (r-a) + \frac{1}{2} \frac{d^{2}U}{dr^{2}} \Big|_{a} (r-a)^{2} = U(a) + \frac{(2n-1)q^{2}}{2a^{3}} = U(a) + \frac{1}{2}\beta(r-a)^{2}$$

$$\beta = \frac{(2n-1)q^{2}}{a^{3}}$$

(3)

(3)

$$m\ddot{\mu}_{2n} = \beta(\mu_{2n+1} + \mu_{2n-1} - 2\mu_{2n})$$

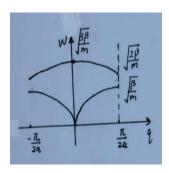
$$2m\ddot{\mu}_{2n+1} = \beta(\mu_{2n+2} + \mu_{2n} - 2\mu_{2n+1})$$

$$\mu_{2n} = Ae^{i(\omega t - 2nka)}, \mu_{2n+1} = Be^{i(\omega t - (2n+1)ka)}$$

$$\Delta = (2\beta - m\omega^2)(2\beta - 2m\omega^2) - 4\beta^2 \cos^2(ka) = 0$$

$$\omega^2 = \frac{\beta}{2m}(3 \pm \sqrt{9 - 8\sin^2(aq)}) = \frac{(2n-1)q^2}{2ma^3}(3 \pm \sqrt{9 - 8\sin^2(aq)})$$
(4)

5



(5)
$$\omega_A = 0, \omega_0 = \sqrt{\frac{3\beta}{m}} = \sqrt{\frac{3(2n-1)q^2}{ma^3}}$$